## 多層積層 AlOx/Fe 触媒を用いた高密度多段積層 CNT フォレストの作製

八田・古田研究室 1160047 上屋 慎之介

【はじめに】カーボンナノチューブ (CNT)は優れた電気特性、ユニークな光学特性を持ち、様々なデバイスへの応用が期待されている。多段構造は高さ毎に CNT 構造に変化させることができ、メタマテリアルなどの光学デバイスへの店用が期待できる。我々は Fe 触媒と支持層 AlN 層を交互に積層する積層触媒で多段積層 CNT フォレストの成長[1]報告している。本研究では高密度 CNT の成長[2]が報告される AlOx を支持層に用いて、高密度多段積層 CNT フォレスト成長を目指す。

【実験方法】RFマグネトロンスパッタ装 置を用い熱酸化 Si 基板上に AlOx/Fe 触媒 を交互に数層積層した(AlOx/Fe)n 触媒を 作製した。2カソードスパッタ装置で AlOx、Fe ターゲットを用い、スパッタ条 件はベース真空度 5×10<sup>-4</sup>Pa、RF 電力 50W(AlO)、25W(Fe)、圧力 1.4Pa、Ar 流 量 25sccm とし、大気開放せず連続し堆 積した。(1)AlOx 膜厚 0.75~24nm、Fe 膜 厚 1nm、触媒積層数 3 層、(2)AlOx 膜厚 6nm、Fe 膜厚 1nm、触媒積層数 1~5 層、 (3)AlOx 膜厚 6nm、Fe 膜厚 0.5~2.5nm、 AlOx 圧力 0.8~9Pa、触媒積層数 3 層と条 件を変更し触媒を作製した。CNT の合成 は熱 CVD 法により、原料ガス C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> を 10sccm、合成温度 730℃、ガス導入前ア ニール時間を 3 分 30 秒、合成時間を 10 分とした。

## ( I )Fe 0.5 nm (a)(b)(c)(d)

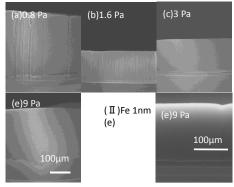


図 1.境界が形成された CNT フォレストの SEM 像(I)Fe0.5nm-AlOx(a)0.8, (b)1.6, (c)3, (d)9Pa(II)(e)Fe1nm-AlOx9Pa

【結果と考察】図 1 に(3)Fe 膜厚 0.5nm、AlOx スパッタ圧力 0.8, 1.6, 3, 9 Pa の条件、Fe 膜厚 1 nm、AlOx スパッタ圧力 9 Pa の条件の 5 条件の熱 CVD 合成後の CNT フォレスト断面 SEM 像を示す。これらの条件でのみ CNT フォレスト断面中に CNT フォレストが途切れた、または折れ曲がった構造(以下、境界と呼ぶ)の形成が見られた。境界付近で CNT フォレストが高密度化、または基板と斜めに成長したと考えられる。

図2に図1で示したCNTフォレストの境界の拡大SEM像と成長モデルを示す。いずれのCNTフォレストでも境界上部で境界下部に比べ密度が高かった。これは、熱CVD合成中に基板の最上段のFe層により $C_2H_2$ ガスが分解され、C原子がAlOx層に挟まれた下段のFe層まで拡散することで下段のFe層と比較しC原子供給量が少なく、下段は上段ほどCNTが成長しなかったと考えた。

【まとめ】(AlOx/Fe)n 触媒の AlOx 膜厚、触媒積層数、Fe 膜厚、AlOx スパッタ圧力を変更し、CNT フォレストの合成を行った。Fe 膜厚、AlOx スパッタ圧力を変更した実験において、CNT フォレスト中に、多段化が期待できる境界が形成されたが多段形成には至らなかった。CNT 密度は、目標  $10^{12}$ /cm² には達しなかった。

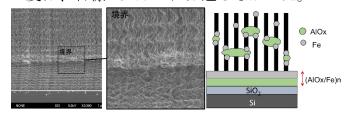


図 2. AIO-9Pa 図 1(e) CNT 境界の拡大 SEM 像と CNT 成長モデル

## 参考文献

- [1] H. Furuta *et al.*, Tech. Proc. 2012 NSTI Nanotech. Conf. & Expo, NSTI-Nanotech (2012)314-317.
- [2] G. Zhong et al., ACS NANO 6(4), (2012) 2893-2903.